

Si基板へのエピタキシャル成長単結晶 薄膜とデバイス応用

Single crystal thin films epitaxially grown on silicon substrates and their device applications

2024 9. 16 Mon 13:00 – 18:00

朱鷺メッセほか2会場 (ハイブリット開催)

従来困難とされてきたヘテロエピタキシャル成長での高品質単結晶化を、革新的なバッファ層で実現し、既存デバイスの飛躍的性能向上を目指した研究が進められています。本シンポジウムでは、バッファ層を用いたエピタキシャル成長で新たに発見された物性やその原理、さらにはその応用について共有したいと思います。エピタキシャル膜は圧電体だけでなく他分野での応用の可能性があり、本シンポジウムが起点となり技術革新の原動力になることを期待し、皆様のご参加と一般講演の投稿をお待ちしています。

招待講演

- 木島 健 (株式会社Gaianixx)
マルテンサイト・エピタキシー
- 吉村 武 (大阪公立大学)
スパッタリング単独プロセスによるSi上強誘電体エピタキシャルキャパシタの形成
- 神野 伊策 (神戸大学)
スパッタ法によるSi基板上エピタキシャルPZT圧電薄膜の作製
- 譚 ゴオン (大阪公立大学)
ゾルゲル法によるSi基板上のエピタキシャル $\text{Pb}(\text{Zr},\text{Ti})\text{O}_3$ 薄膜の作製と評価
- 吉田 慎哉 (芝浦工業大学)
巨大圧電性を有するPMN-PT系単結晶薄膜のSi基板上へのエピタキシャル成長
- 柳谷 隆彦 (早稲田大学)
ScAlNおよび LiNbO_3 エピタキシャル圧電薄膜のBAWフィルタ応用の現状

※講演順、敬称略